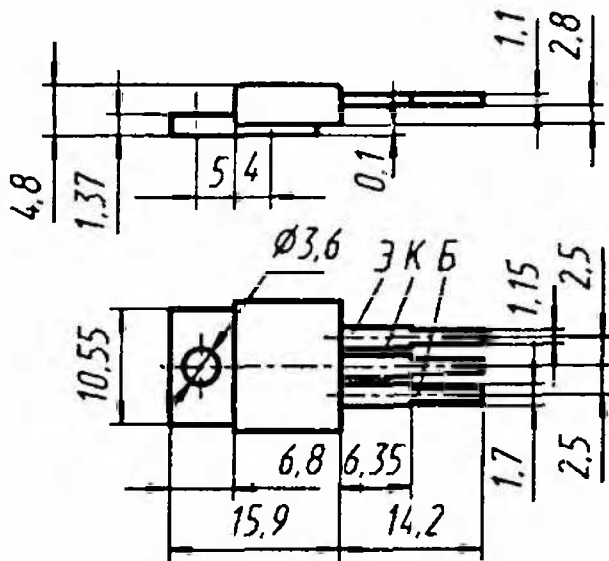


## КТ858А

КТ858А



Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *n-p-n* переключа- тельный. Предназначен для применения в переключаю- щих устройствах. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 3 г.

Изготовители — акцио- нерное общество «Крем- ний», г. Брянск, завод «Ис- кра», г. Ульяновск.

### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кэ} = 5$ В, $I_k = 5$ А, не менее	10
Модуль коэффициента передачи тока на вы- сокой частоте при $U_{кэ} = 10$ В, $I_k = 0,5$ А, $f = 3$ МГц, не менее	3,3
Граничное напряжение при $I_k = 0,1$ А, $L = 25$ мГн, не менее	200 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 5$ А, $I_b = 0,8$ А, не более	1 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 5$ А, $I_b = 0,8$ А, не более	1,2 В
Время спада при $U_{кэ} = 50$ В, $I_k = 5$ А, $I_b = 0,5$ А, $U_{бэ} = -5$ В	0,05*...0,3*... 0,75* мкс
Время рассасывания при $U_{кэ} = 50$ В, $I_k = 5$ А, $I_b = 0,5$ А, $U_{бэ} = -5$ В	1*...1,2*... 2,5 мкс
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 400$ В, не более	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{бэ} = 6$ В, не более	1 мА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер <sup>1</sup> при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ Ом}$ , $T_{п} = +100 \text{ }^\circ\text{C}$ .....	400 В
Пробивное напряжение коллектор—база <sup>1</sup> при $T_{п} = +100 \text{ }^\circ\text{C}$ .....	400 В
Постоянное напряжение база—эмиттер .....	6 В
Постоянный ток коллектора .....	7 А
Импульсный ток коллектора .....	10 А
Постоянный ток базы .....	4 А
Импульсный ток базы .....	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>2</sup> при $T_{п} = -55...+25 \text{ }^\circ\text{C}$ .....	60 Вт
Температура $p$ - $n$ перехода .....	+150 $^\circ\text{C}$
Температура окружающей среды .....	-55... $T_{к} =$ = +100 $^\circ\text{C}$

<sup>1</sup> При  $T_{п} = +100...+150 \text{ }^\circ\text{C}$  напряжение снижается линейно до 200 В.

<sup>2</sup> При  $T_{к} > +25 \text{ }^\circ\text{C}$   $P_{к \text{ макс}}$  считается по формуле

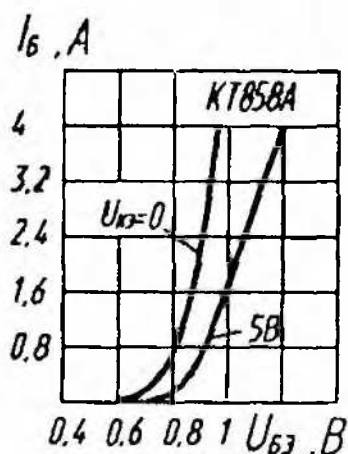
$$P_{к \text{ макс}} = (150 - T_{к}) / R_{т (п-к)} \text{ Вт,}$$

где  $R_{т (п-к)}$  определяется из области максимальных режимов.

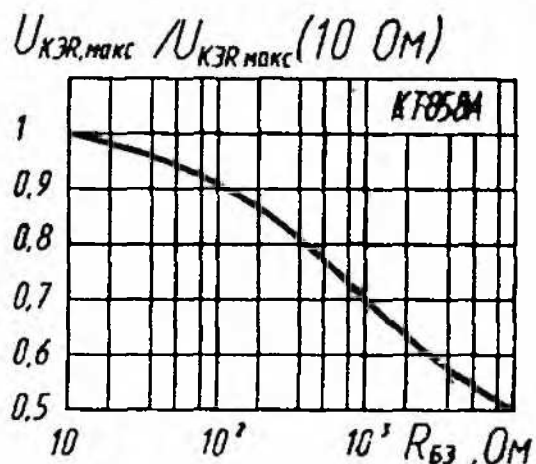
Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса, при пайке температура корпуса не более +100  $^\circ\text{C}$ . При отсутствии контроля температуры корпуса пайка производится паяльником с температурой не более +280  $^\circ\text{C}$  в течение не более 2,5 с. Допускается пайка волной припоя.

При монтаже транзистора должны быть приняты меры, исключающие возникновение паразитной генерации.

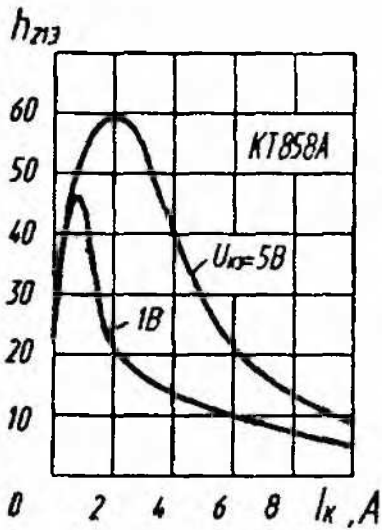
Допустимое значение статического потенциала 2000 В.



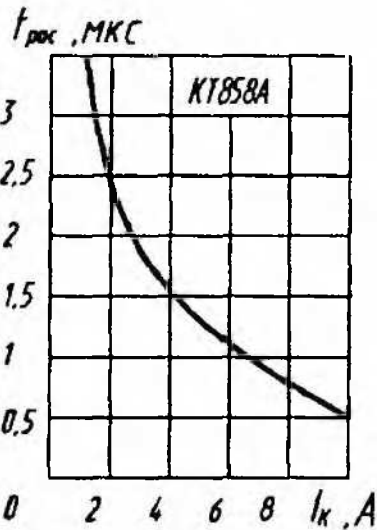
Входные характеристики



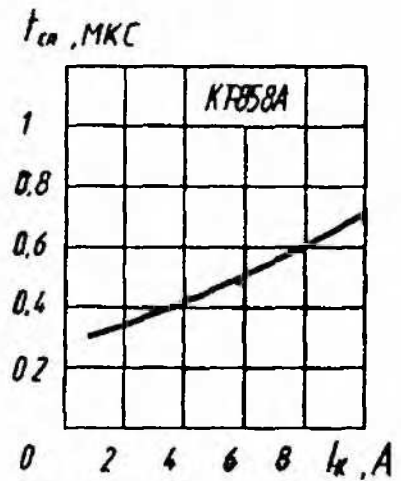
Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



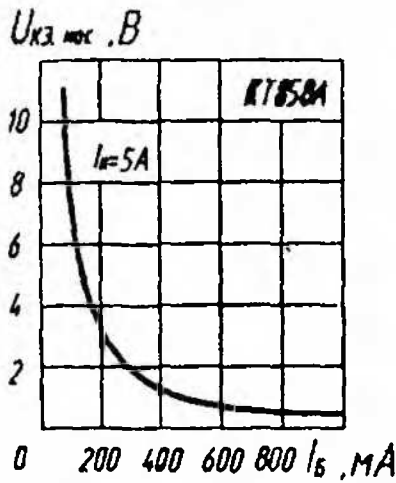
Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



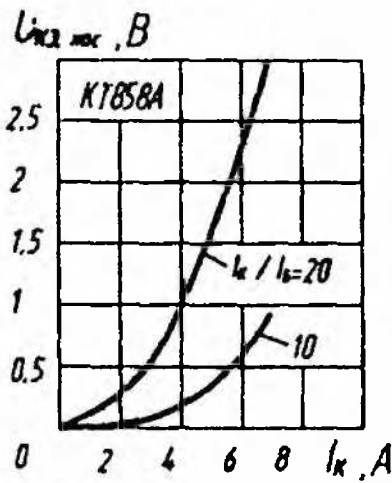
Зависимость времени рассасывания от тока коллектора



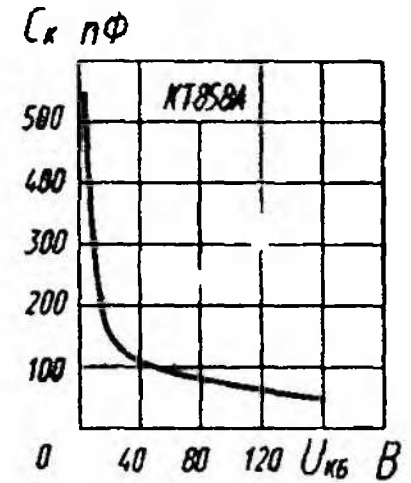
Зависимость времени спада от тока коллектора



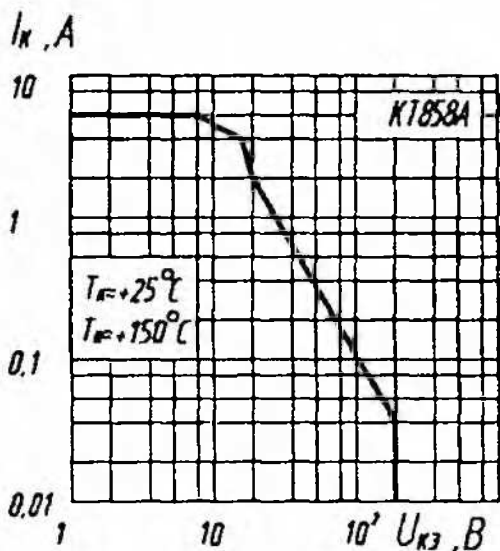
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы



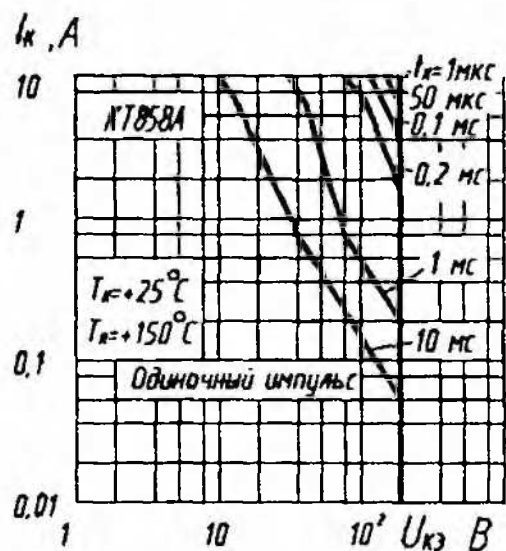
Зависимости напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор-база



Область максимальных режимов



Области максимальных режимов